



文部科学省 地域イノベーションクラスタープログラム（グローバル型）

東海広域ナノテクものづくりクラスター
「高効率光・パワーデバイス部材の開発」

主催：（財）科学技術交流財団、豊橋技術科学大学・ベンチャービジネスラボラトリー（VBL）
共催：（株）豊橋キャンパス・イノベーション（とよはし TL0）

「窒化物半導体デバイスプロセス講習会」のご案内

財団法人科学技術交流財団では地域イノベーションクラスタープログラム（グローバル型）東海広域ナノテクものづくりクラスターの事業の一環として、窒化物半導体産業の技術開発の現状や応用など、より多くの窒化物半導体に応用に携わる企業や大学の技術者、研究者への情報交換を含めたシナジーの創出や人的交流を目的とした「窒化物半導体応用研究会」を平成20年よりこれまで7回に渡って開催しております。

窒化物半導体の応用・製品化にはデバイスプロセスの全過程を理解することが必要不可欠です。そこで、今回窒化物半導体応用研究会の活動として、デバイスプロセスの一連の流れを企業の技術者の皆様に学習していただく講習会を開催することにいたしました。

最初の講習会となる今回は、「GaN系発光ダイオードの製作と評価」について、豊橋技術科学大学の試作製造設備を使用した実習を行い、実際の現場で活かせるようになって頂きます。関心ある企業の皆様の多数のご応募をお待ち致しております。

記

【日 時】 平成22年9月6日（月）～7日（火）の2日間 午前9時～午後5時

【場 所】 国立大学法人 豊橋技術科学大学 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
〒441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘 1-1

【内 容】 **テーマ「GaN系発光ダイオードの製作と評価」**
－各自のウエハで素子の作製と計測・評価を行う－

- 主な工程
- ①概要説明
 - ②素子分離（ホトリソ、ICP-RIE）
 - ③n型電極（ホトリソ、蒸着、リフトオフ、シンタ）
 - ④p型電極（ホトリソ、蒸着、リフトオフ、シンタ）
 - ⑤SiO₂保護膜形成（プラズマCVD）
 - ⑥コンタクトホール形成（ホトリソ、エッチング）
 - ⑦特性チェック（I-V、L-I、スペクトル）

【参加費】 2万円（税込み）／名 *材料費、着衣貸出し等の費用を含みます。

【定 員】 10名程度（未経験者でもご参加頂けます。）
*申込者多数の場合には、選考の上、決定いたします。

【申込方法】 指定の申込み用紙に、必要事項をご記入いただき、
（財）科学技術交流財団（cluster2008@astf.or.jp）まで、メールにてお申込み下さい。

【締切日】 平成22年8月2日（月）迄



文部科学省 地域イノベーションクラスタープログラム（グローバル型）
東海広域ナノテクものづくりクラスター
「高効率光・パワーデバイス部材の開発」

「窒化物半導体デバイスプロセス講習会」申込用紙

以下のフォームにご記入の上、【cluster2008@astf.or.jp】までE-mailにてお申し込みください。

受講者氏名	
会社名	
住 所	
所 属	
役 職	
E-mail	
電 話	
業務内容	
服のサイズ	S / M / L / LL / 3L / 4L
靴のサイズ	(cm)
講習会に期待すること	

参加費については、受講者決定後に、事務局指定の口座にお振込みいただきます。
なお、一度お振込みいただいた参加費は、ご返金できませんので予めご了承ください。

■窒化物半導体デバイスプロセス講習会事務局

財団法人科学技術交流財団 東海広域知的クラスター創成事業本部(担当 木村・伊藤(敏)・長)
〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目4-7 愛知県産業貿易館西館7階
TEL:052-231-1656 FAX:052-231-1640 URL:<http://www.astf.or.jp/cluster/>
E-mail: cluster2008@astf.or.jp